

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 83 回委員会・第 87 研究会 開催案内 (案)
(結晶成長の科学と技術第 161 委員会と合同研究会)

日時：平成 25 年 12 月 13 日(金)・14 日(土)

委員会：14 日 12:30-13:30

研究会：13 日 15:00-16:40

14 日 09:00-12:15、13:30-15:00

意見交換会：13 日 18:30-20:30

場所：サンバレー富士見

(伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅より徒歩10分/東名 沼津ICより45分)

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈 185-1 TEL: 055-947-3100

<http://www.izu3800.jp/hotel/fujimi.html>

委員会

議 題：

- (1) 前回第 82 回委員会議事要録承認について
- (2) 次回第 88 回研究会について
- (3) 平成 26 年度の研究会計画について
- (4) 第 13 回名古屋大学赤崎記念研究センターシンポジウム(11/28(木)@名大)協賛の事後承認について
- (5) 2014 年度日独西ワークショップの開催について
- (6) その他

報告事項：

- (1) 産学協力研究委員会委員長会議報告
- (2) H26 年度産学協力研究事業申請について
 - ・国際シンポジウム開催経費(運営費交付金)：2014 年度日独西ワークショップ
 - ・協力会特別事業(シンポジウム・成果刊行)：2014 年度日独西ワークショップ
- (3) ワイドギャップ半導体スクール(10/25(金)-10/27(日)@檀原ロイヤルホテル)開催報告
- (4) 第 13 回名古屋大学赤崎記念研究センターシンポジウム(11/28(木)@名大)開催報告
- (5) その他

研究会

主 題：「ワイドギャップ半導体のヘテロ制御とデバイスへの展開」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(15:00-15:10)

13 日 午後 (窒化物半導体成長におけるヘテロ界面制御の進展)

1. 「異種基板上への窒化物エピタキシーにおけるヘテロ界面の科学」(15:10-15:55)

藤岡 洋(東京大学)

2. 「有機金属気相成長法によるグラファイト基板上 GaN 薄膜の結晶成長」 (15:55-16:40)

瀧澤 俊幸 (パナソニック(株))

オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社)

意見交換会(18:30-20:30)

14日 午前 (窒化物半導体 on Si の新技術とデバイス)

3. 「Si 基板上への化合物半導体のエピタキシーと応用」 (9:00-9:45)

若原 昭浩 (豊橋技術科学大学)

4. 「大口径 SiC on Si 基板および GaN エピタキシャル成長」 (9:45-10:30)

川村 啓介 ((株)エア・ウォーター総合開発研究所)

休 憩 (10:30-10:45)

5. 「電力用途 GaN-HEMT の最近の進展と今後に向けて」 (10:45-11:30)

吉川 俊英、細田勉、廣瀬達也、浅井祥守 (富士通セミコンダクター&富士通研究所)

6. 「Si 基板上の GaN を用いた集積型 MEMS」 (11:30-12:15)

羽根 一博 (東北大学)

委員総会(162 委員会) (12:30-13:30)

14日午後 (ヘテロ界面制御技術とデバイス展開)

7. 「MOVPE におけるヘテロ界面成長その場観察と制御技術」 (13:30-14:15)

杉山 正和 (東京大学)

8. 「III 族窒化物および High-k 材料を用いたダイヤモンド電子デバイス」 (14:15-15:00)

小出 康夫 (物質・材料研究機構)

<追記>

- 12月14日(土)の委員会では、ご出席の委員に昼食をご用意いたします。
- 12月13日(金)の研究会終了後に意見交換会を行います。
宿泊なしで意見交換会に出席ご希望の方は、担当幹事の本田先生(名古屋大学)(honda@nagoya-u.jp)までお早めにご相談ください。
- 委員会・研究会へのご出欠回答を、**11月25日(月)**までに日本学術振興会研究事業課 檜崎様(jigyouka09@jsps.go.jp)に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
- 宿泊につきましては、添付の申込書により直接(株)アートツーリストへお申し込みください。
締切は11月28日(木)です。